



中华人民共和国国家标准

GB/T 249—2026

代替 GB/T 249—2017

半导体分立器件型号命名方法

Rule of type designation for discrete semiconductor devices

2026-02-27 发布

2026-09-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 249—2017《半导体分立器件型号命名方法》，与 GB/T 249—2017 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了碳化硅、氮化镓、金刚石等化合物半导体器件的命名方法(见表 1)；
- b) 增加了 ESD 保护器件的命名(见表 2)；
- c) 增加了 IGBT 的型号命名(见表 2)；
- d) 增加了数字晶体管的命名(见表 2)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC 78)归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、北京微电子技术研究所、锦州辽晶电子科技股份有限公司、山东芯诺电子科技股份有限公司、西安卫光科技有限公司、西安环宇芯微电子有限公司、国家国防科技工业局军工项目审核中心、中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)。

本文件主要起草人：闫美存、张秋、马睿彤、曹燕红、高广亮、陈浩、麻欣、朱海马、裘国营、陈骞、周建国、李娜、戴俊夫、田燕春、赵曜。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1964 年首次发布为 GB/T 249—1964，1974 年第一次修订，1989 年第二次修订，2017 年第三次修订；
- 本次为第四次修订。

半导体分立器件型号命名方法

1 范围

本文件规定了半导体分立器件型号的命名方法。
本文件适用于各种半导体分立器件的型号命名。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

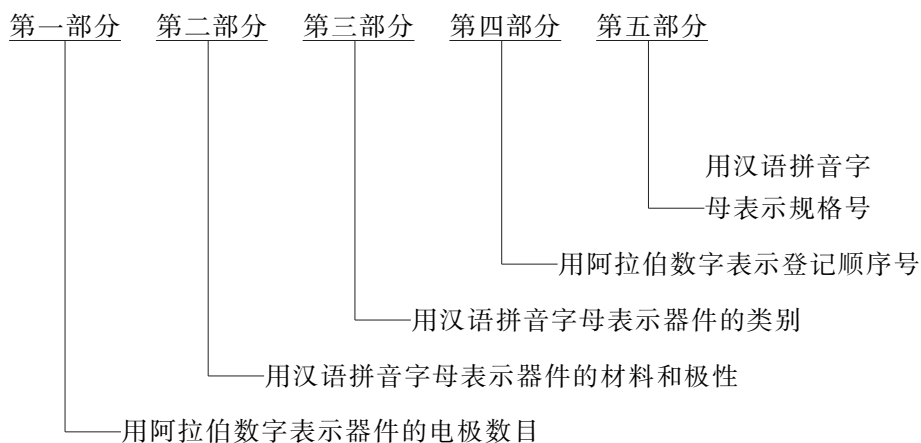
GB/T 17573—2026 半导体器件 总则

3 术语和定义

GB/T 17573—2026 界定的术语和定义适用于本文件。

4 型号组成原则

4.1 半导体分立器件的型号五个组成部分的基本意义如下:



4.2 半导体分立器件的型号一般由第一部分~第五部分组成,也可由第三部分~第五部分组成。

5 型号组成部分的符号及其意义

5.1 由第一部分~第五部分组成的器件型号的符号及其意义见表1。